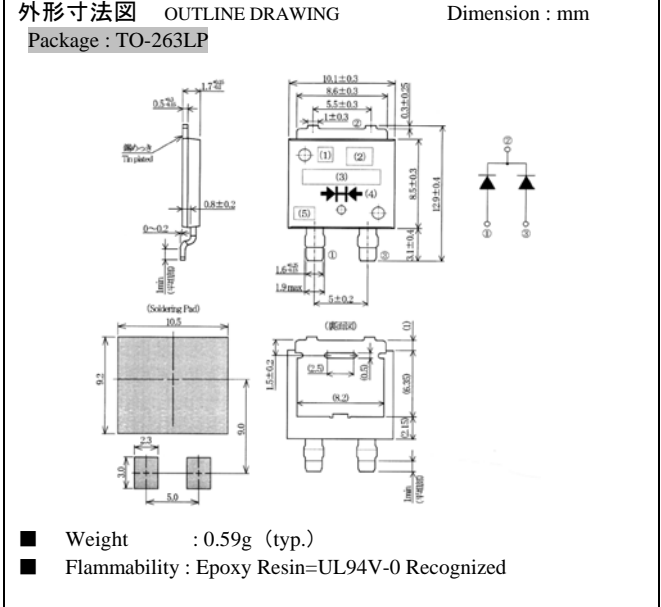


UCQS20A065

構造：ショットキーバリアダイオード (SBD)
 Construction : Schottky Barrier Diode
 用途：高周波整流用
 Application : High-Frequency Rectification

特長 **Feature**
 薄型 SMD Lower Profile SMD
 低熱抵抗 Lower Thermal-Resistance
 高電流 High Current Capability
 Tj=150°C Tj=150°C



■ 絶対最大定格 (表示無き場合 Ta=25°C) Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 °C unless otherwise stated)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Rating	単位 Units
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	—	65	V
平均整流電流 Average Rectified Output Current	I _O	50Hz 正弦全波, 抵抗負荷 T _C =117°C VRM=30V 50H Full Sine Wave, Resistive Load	20	A
実効順電流 RMS Forward Current	I _{F(RMS)}	—	22.2	A
サージ順電流 Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦全波 1 サイクル 非繰り返し 50Hz Full Sine Wave, 1 cycle, Non-repetitive	220	A
動作接合温度範囲 Operation Junction Temperature Range	T _{jw}	—	-40~+150	°C
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T _{stg}	—	-40~+150	°C

■ 電氣的・熱的特性 Electrical / Thermal Characteristics

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	最小値 min.	代表値 typ.	最大値 max.	単位 Units
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I _{RM}	VRM=VRRM, Tj=25°C, Per diode	—	—	1	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	V _{FM}	IFM=10A, Tj=25°C, Per diode	—	—	0.60	V
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f=100kHz, VR=10V, Per diode	—	290	—	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(j-c)}	接合部・ケース間 Junction to Case	—	—	2	°C/W

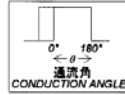
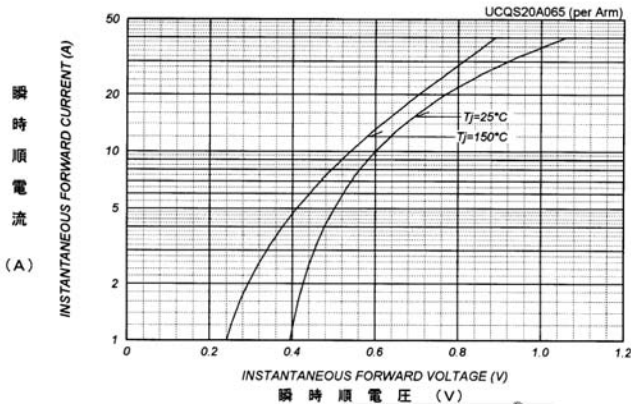
● 本資料の記載内容は製品改良などのため予告なく変更することがあります。
 ● The content specified herein is subject to change without notice.

UCQS20A065

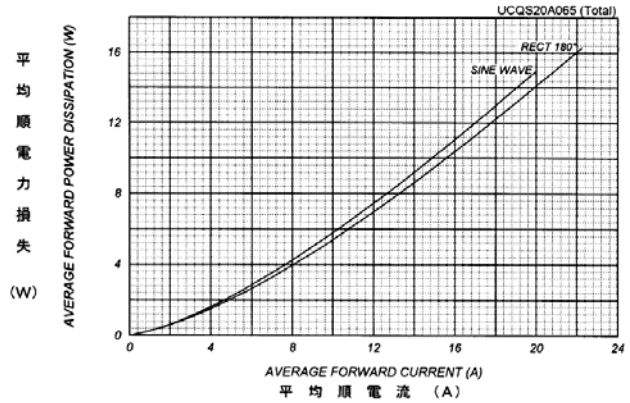
DSE-13054 (2/2)

■ 特性図 Characteristics Diagrams

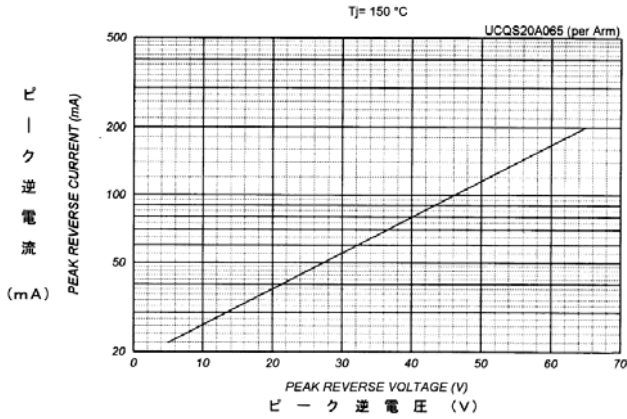
順電圧特性
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE



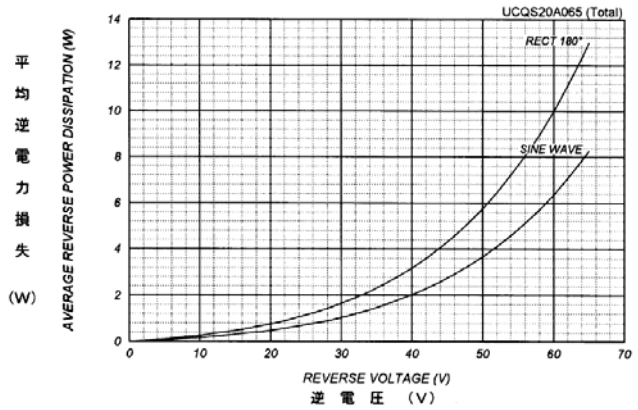
平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION



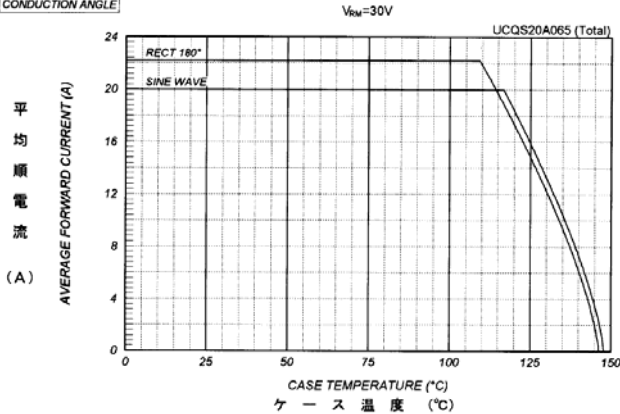
ピーク逆電流 - ピーク逆電圧特性
PEAK REVERSE CURRENT VS. PEAK REVERSE VOLTAGE



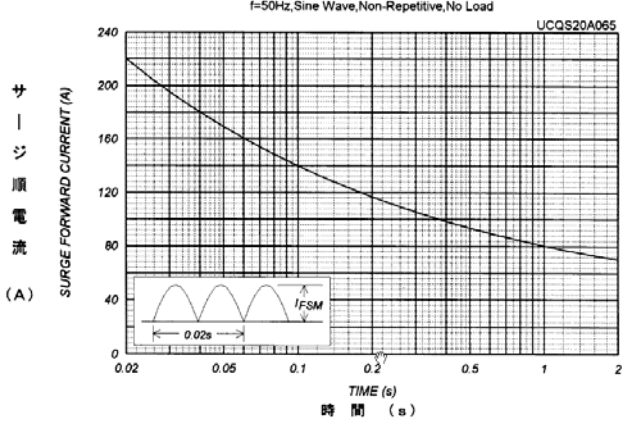
平均逆電力損失
AVERAGE REVERSE POWER DISSIPATION



平均順電流 - ケース温度定格
AVERAGE FORWARD CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



サージ順電流定格
SURGE CURRENT RATINGS



接合容量特性
JUNCTION CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE

